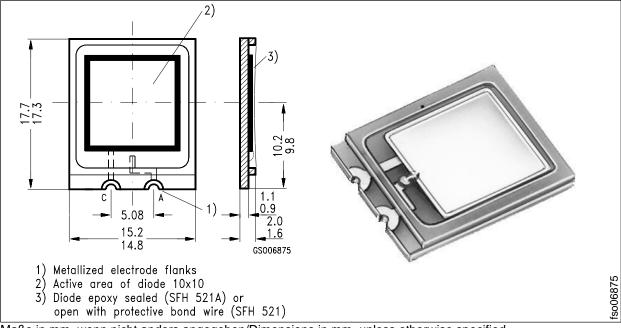
SIEMENS

α -β- γ -Strahlungsdetektoren α -β- γ -Radiation Detectors

SFH 521 SFH 521 A



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Eigenschaften

Substratscheibe: $4600 \pm 1400 \ \Omega \text{cm}$ Chipdicke: $381 \pm 15 \ \mu \text{m}$

Vorderseite: Aluminiumkontakt 1.4 μm

Aluminiumabdeckung ganzflächig 0,1 μm

Rückseite: 0,4 μm Gold/Arsen

Kleiner Dunkelstrom

Niedrige Kapazität

Hohe Durchbruchspannung ermöglicht Betrieb bei voll ausgeräumten Chip

Features

Substrate: $4600 \pm 1400 \ \Omega \text{cm}$ Chip thickness: $381 \pm 15 \ \mu \text{m}$

Topside: Aluminium contact 1.4 μm

Aluminium total cover 0.1 µm

Backside: 0.4 µm Au/As

Low dark current

Low capacitance

• High breakdown voltage permits operation at full depletion

Bestellnummer Ordering Code
Q62702-P420
Q62702-P430

SIEMENS

Kennwerte Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Sperrspannung Breakdown voltage 100 μA	V_{R}	> 180	V
Dunkelstrom Dark current 100 V 170 V	I_{R}	(< 25) 20 (< 50)	nA
Flußspannung Forward voltage 100 mA	V_{F}	0.7 (< 2)	V
Kapazität Capacitance $f = 1 \text{ MHz}, E_v = 0$ 80 V 150 V	С	40 30	pF
Kapazität pro cm ² Capacitance per cm ² 120 V	C/cm ²	32	pF
Betriebsspannung Operating voltage	V_{op}	90 120	V
Ladungsträger - Lebensdauer Charge carrier lifetime	-	10	msec.

Current and Capacitance Characteristics per cm²

